









	<p><b>SI7485DP-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7485DP-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 12.5A PPAK SO-8</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  SI7485DP-T1-GE3.pdf</p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 800460 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI7485DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 12.5A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	800460 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 12.5A (Ta) 1.8W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.3 mOhm @ 20A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7485DP-T1-GE3DKR

SI7485DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7485DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7485DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7485DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7485DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 12.5A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7485DP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 12.5A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7485DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12.5A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7489DP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 28A PPAK SO-8</p>
 <p><b>SI7489DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 28A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7485DP</b> SI SI7485DP SI</p>	 <p><b>SI7489DP</b> Vishay Precision Group SI7489DP VISHAY</p>	 <p><b>SI7483DP-T1-GE3</b> VB SI7483DP-T1-GE3 VB</p>

heiße Teile

Mehr

SI7464DP-T1-E3	SI7464DP-T1-GE3	SI7464DP-T1-GE3	SI7465DP-T1-E3	SI7465DP-T1-E3
SI7465DP-T1-GE3	SI7465DP-T1-GE3	SI7470DP-T1-GE3	SI7476DP-T1-GE3	SI7476DP-T1-GE3
SI7478DP	SI7478DP-T1-E3	SI7478DP-T1-E3	SI7478DP-T1-GE3	SI7478DP-T1-GE3
SI7483ADP	SI7483ADP-T1-E3	SI7483ADP-T1-E3	SI7483ADP-T1-GE3	SI7483ADP-T1-GE3
SI7483DP-T1	SI7483DP-T1-E3	SI7483DP-T1-GE3	SI7485DP-T1-E3	SI7485DP-T1-E3
SI7485DP-T1-GE3	SI7489DP	SI7489DP-T1-GE3	SI7489DP-T1-GE3	SI7491DP
SI7491DP-T1-GE3	SI7491DP-T1-GE3	SI7501DN-T1-E3	SI7501DN-T1-E3	SI7540ADP-T1-GE3
SI7540ADP-T1-GE3	SI7540DP-T1-E3	SI7540DP-T1-E3	SI7540DP-T1-GE3	SI7540DP-T1-GE3
SI7606DN-T1-E3	SI7606DN-T1-GE3	SI7611DN-T1-GE3	SI7611DN-T1-GE3	SI7613DN-T1-GE3
SI7613DN-T1-GE3	SI7615ADN-T1-GE3	SI7615ADN-T1-GE3	SI7615DN	SI7615DN-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited